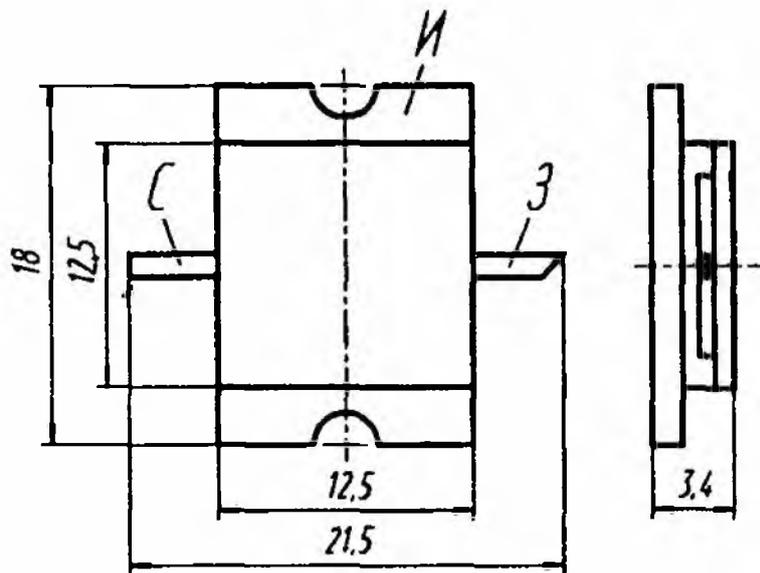


ЗП915А-2, ЗП915Б-2

Транзисторы псевые арсенидогаллиевые эпитаксиально-планарные с барьером Шотки и каналом л-типа сверхвысоко-частотные генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности и автогенераторах на частотах до 8 ГГц в герметизированной аппаратуре. Бескорпусные с гибкими выводами на металлокерамическом кристаллодержателе. Тип прибора указывается на крышке кристаллодержателя.

Масса транзистора не более 5 г.

ЗП915 (А-2, Б-2)



Электрические параметры

Выходная мощность при $U_{си} = 7$ В, $f = 8$ ГГц,
 $T_K = +25$ °С:

$P_{вх} = 2,5$ Вт для ЗП915А-2	5...5,8*...7* Вт
$P_{вх} = 1,5$ Вт для ЗП915Б-2	3...3,5*... 4,2* Вт

Коэффициент усиления по мощности
при $U_{си} = 7$ В, $f = 8$ ГГц, $T_K = +25$ °С:

$P_{вх} = 2,5$ Вт для ЗП915А-2	3...3,65*... 4,45* дБ
$P_{вх} = 1,5$ Вт для ЗП915Б-2	3...3,65*... 4,45* дБ

Коэффициент усиления по мощности в линейной области амплитудной характеристики при $U_{си} = 4$ В, $f = 8$ ГГц, $P_{вх} = 0,3$ Вт, $T_K = +25$ °С,

не менее	3 дБ
Коэффициент полезного действия	
при $U_{си} = 7$ В, $f = 8$ ГГц, $T_K = +25$ °С:	
$P_{вх} = 2,5$ Вт для 3П915А-2	25...35*...40*%
$P_{вх} = 1,5$ Вт для 3П915Б-2	15...22*...30*%
Крутизна характеристики при $U_{си} = 1,5$ В, $I_c = 0,5$ А:	
3П915А-2	350...800*... 1200* мА/В
3П915Б-2	300...700*... 1000* мА/В
Ток утечки затвора при $U_{зи} = -5$ В, не более:	
$T = +25$ °С	1 мА
$T = -60$ °С	1 мА
$T = +85$ °С	5 мА

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение питания на стоке	7 В
Постоянное напряжение затвор—исток	5 В
Потенциал статического электричества	30 В
Постоянная рассеиваемая мощность ¹ :	
$T_K = -60...T_K = +40$ °С	12 Вт
$T_K = +85$ °С	8 Вт
Температура структуры	+170 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_K =$ = +85 °С

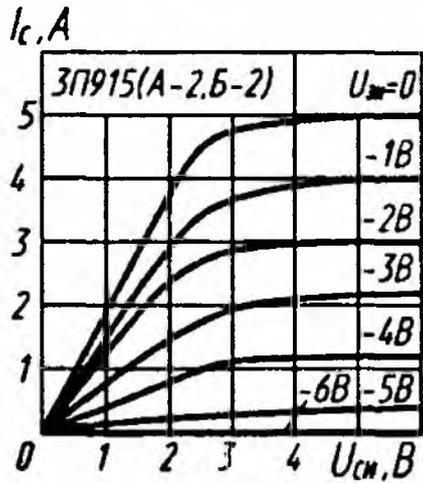
¹ Максимально допустимое значение средней рассеиваемой мощности в динамическом режиме определяется по формуле:

$$P_{ср, макс} = U_c I_c - P_{вых} + P_{вх}, \text{ Вт.}$$

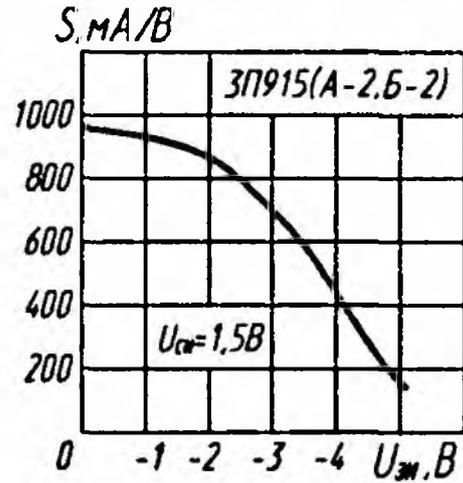
В диапазоне температур кристаллодержателя +40...+85 °С допустимые значения рассеиваемой мощности снижаются линейно.

Допускается однократный изгиб выводов не ближе 2 мм от кристаллодержателя и обрезка выводов не ближе 1 мм от кристаллодержателя. Растягивающая выводы сила не должна превышать 25 Н.

Минимальное расстояние от места пайки выводов до кристаллодержателя 2 мм при температуре пайки не выше +260 °С. Допускается пайка (сварка) выводов на расстоянии 0,5 мм от кристаллодержателя при длительности не более 3 с, температуре не выше +150 °С и обеспечении отвода теплоты от вывода между местом пайки и кристаллодержателя.



Выходные характеристики



Зависимость крутизны характеристики от напряжения затвор—исток